

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

จ.ชลบุรี อ.เมือง ช.ชลบุรี 2013।

โครงการและสมบัติทางแสงของพิล์มนบางช่อร์โโคเนียมออกไซด์

ที่เคลื่อนด้วยวิธี รีแอคติฟ ดีซี แมกนีตรอน สปีตเตอริง

จินดาวรรณ ธรรมบริรา

26 เม.ย. 2554

285867

บีบารี ๑๕

๑๓ ชั้น ๔

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชาพิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

มีนาคม 2554

ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยบูรพา

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้พิจารณา
วิทยานิพนธ์ของ จินดาวรรณ ธรรมปิรีชา ฉบับนี้แล้ว เห็นสมควรรับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา¹
ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของมหาวิทยาลัยบูรพา ได้

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

..... อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศิงห์ ไชยคุณ)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

..... ประชาน
(ดร.วิเชียร ศิริพร)

..... กรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศิงห์ ไชยคุณ)

..... กรรมการ
(ดร.อรรถพล เชยคุภากุตุ)

..... กรรมการ
(ดร.ณัฐพงษ์ ศรีสุข)

คณะกรรมการต้อนรับให้รับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ของมหาวิทยาลัยบูรพา

..... คอมบีคณะกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาวดี ตันติวนานุรักษ์)
วันที่ ๑๕ ดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

การวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

จากมหาวิทยาลัยบูรพา

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2553

และ

ทุนผู้ช่วยวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศค้านฟิสิกส์

สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

ประกาศคุณูปการ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงด้วยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย์ สุรศิงห์ ไชยคุณ
อาจารย์ที่ปรึกษา ขอขอบคุณดร.วิเชียร ศิริพร ที่ให้ความกรุณาเป็นประธานกรรมการสอบ
ขอขอบคุณดร.อรรถพล เชยศุภเกตุ ที่ให้ความกรุณาเป็นกรรมการสอบ และดร.ณัฐพงษ์ ศรีสุข
ตัวแทนฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็น
กรรมการสอบ รวมถึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิรันดร์ วิทิตอนันต์ ที่กรุณาให้คำปรึกษาแนะนำ
ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความละเอียดถี่ถ้วน และเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมา ผู้วิจัยสืบ
ทราบซึ่งเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้

ผู้วิจัยขอขอบคุณเหล่าทุนที่ให้การสนับสนุนงานวิจัยนี้ โดยวิทยานิพนธ์นี้ได้รับทุน
สนับสนุนบางส่วนจาก ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยบูรพาประจำ
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2553 และ ได้รับทุนสนับสนุนหลักจาก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพิสิกส์
ภายใต้การกำกับของ โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สนว.)
(PERDO) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ และบุคลากรของห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสัญญาศาสตร์และ
พิลามนง (VTTF) และห้องปฏิบัติการวิจัยพลาสม่าสำหรับวิทยาศาสตร์พื้นผิว (PSS) ภาควิชาพิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ให้ความอนุเคราะห์และช่วยเหลือในการทำวิจัยด้วยดี
นายอดิศร บูรณวงศ์ ที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตัวอย่างในวิทยานิพนธ์นี้

สุดท้ายขอขอบคุณ พ่อแม่ ที่เคยให้ความช่วยเหลือเป็นกำลังใจ ทั้งทางด้านร่างกาย
และจิตใจ คับข้าพเจ้าตลอด รวมถึง พี่น้อง และหมู่朋 เพื่อนทุกคน รวมทั้งท่านอื่น ๆ ที่มิได้
เอียนามในที่นี้ ที่เคยให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือ ซึ่งมีส่วนทำให้การทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
สำเร็จได้ด้วยดี

จินดาวรรณ ธรรมบูรพา

52910041: สาขาวิชา: ฟิสิกส์; วท.ม. (ฟิสิกส์)

คำสำคัญ: พิล์มนบาง/ เซอร์โคเนียมออกไซด์/ รีแอคติฟ ดีซี แมกนีตรอน สปีตเตอริง/
ค่าคงที่ทางแสง / วิธี Swanepoel

จินดาวรรณ ธรรมปริชา: โครงสร้างและสมบัติทางแสงของพิล์มนบาง

เซอร์โคเนียมออกไซด์ที่เคลือบด้วยวิธี รีแอคติฟ ดีซี แมกนีตรอน สปีตเตอริง (STRUCTURAL AND OPTICAL PROPERTIES OF ZrO_2 THIN FILMS DEPOSITED BY REACTIVE DC MAGNETRON SPUTTERING) คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์: สุรศิษฐ์ ไชยคุณ, Ph.D.

130 หน้า. ปี พ.ศ. 2554.

พิล์มนบางเซอร์โคเนียมออกไซด์ (ZrO_2) ถูกเคลือบนกระจกสีไลด์ และแผ่นซิลิโคน ด้วยวิธี รีแอคติฟ ดีซี แมกนีตรอน สปีตเตอริง ผลของเงื่อนไขการเคลือบได้แก่ อัตราไฟลแก๊สออกซิเจน ระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับ และความหนาของพิล์มนเซอร์โคเนียมออกไซด์ ดังถูกศึกษา ทั้งนี้ สมบัติของพิล์มนบางเซอร์โคเนียมออกไซด์ที่เคลือบได้ เช่น โครงสร้างผลึก ลักษณะพื้นผิว ความหนา และค่าการส่งผ่านแสง ถูกตรวจสอบด้วย X-ray diffraction (XRD), atomic force microscopy (AFM) และスペคโตร ไฟฟอโตเมตรตามลำดับ ค่าคงที่ทางแสงและแบบพลังงานของพิล์มที่เคลือบได้คำนวณจากสเปคตรัมการส่งผ่านแสง ผลการศึกษาพบว่าสามารถเคลือบพิล์มนเซอร์โคเนียมออกไซด์ที่มีโครงสร้างผลึกแบบโมโนคลินิกบนวัสดุรองรับได้ โดยอัตราไฟลแก๊สออกซิเจนไม่มีผลต่อโครงสร้างและลักษณะพื้นผิวของพิล์ม ขณะที่ระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับและความหนามีผลต่อโครงสร้างและลักษณะพื้นผิวของพิล์ม ค่าคงที่ทางแสงที่ความยาวคลื่นแสง 550 nm พบร่วมมีดัชนีหักเห (n) และสัมประสิทธิ์การดับสูญ (k) เท่ากับ 2.06 และ 0.0009 ตามลำดับ และค่าแบบพลังงาน (E_g) มีค่าประมาณ 4.18 eV

52910041: MAJOR: PHYSICS; M.Sc. (PHYSICS)

KEYWORDS: THIN FILM/ ZIRCONIUM OXIDE / REACTIVE DC MAGNETRON
SPUTTERING/ OPTICAL CONSTANT / SWANEPOEL METHOD

JINDAWAN THAMMAPREECHA: STRUCTURAL AND OPTICAL PROPERTIES
OF ZrO_2 THIN FILMS DEPOSITED BY REACTIVE DC MAGNETRON SPUTTERING.

ADVISORY COMMITTEE: SURASINGH CHAIYACOUN, Ph. D. 130 P. 2011.

Zirconium oxide (ZrO_2) thin films were deposited on glass slides and silicon wafers by reactive DC magnetron sputtering method. The effects of deposition parameter such as O_2 gas flow rate, substrate-target distance, and thickness have been investigated. The properties of the as-deposited ZrO_2 thin film such as crystal structure, surface morphology, thickness and transmittance were characterized by X-ray diffraction (XRD), atomic force microscopy (AFM), and spectrophotometer, respectively. Optical constant and energy band gap of the as-deposited were evaluated from transmission spectra. The results showed that ZrO_2 thin films with monoclinic phase were successfully deposited on substrates. The O_2 flow rate was not effected on the crystal structure and surface morphology of films, whereas substrate-target distance and thickness were effect on the crystal structure and surface morphology of films. The refractive index (n) and extinction coefficient (k) at wavelength 550 nm were 2.03 and 0.001, respectively, while energy band gap (E_g) was approximately 4.18 eV.

สารบัญ

บทคัดย่อภาษาไทย.....	หน้า ๑
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	๒
สารบัญ.....	๓
สารบัญตาราง.....	๔
สารบัญภาพ.....	๕
บทที่	๖
1 บทนำ.....	๑
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	๑
วัตถุประสงค์ของการวิจัย.....	๓
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย.....	๓
ขอบเขตของการวิจัย	๓
2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	๔
กระบวนการเคลือบพิล์มบาง	๔
การก่อเกิดพิล์มบาง	๕
โครงสร้างของพิล์มบาง	๗
การเคลือบพิล์มบางด้วยวิธีสปั๊ตเตอริง	๙
กระบวนการ โกล์ว์ดิ沙ร์จ	๑๖
ระบบเคลือบแบบ ดีซี สปั๊ตเตอริง	๒๑
ระบบเคลือบแบบ ดีซี แมกนีตรอน สปั๊ตเตอริง	๒๓
ระบบเคลือบแบบ อันบาลานซ์ แมกนีตรอน สปั๊ตเตอริง	๒๗
การเคลือบพิล์มบางด้วยวิธี รีแอคตีฟ สปั๊ตเตอริง	๓๐
การหลักณะเฉพาะของพิล์มบาง	๓๒
เซอร์โคเนียมออกไซด์	๔๑
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	๔๖

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
3 วิธีดำเนินการวิจัย	50
กรอบแนวคิดของงานวิจัย.....	50
เครื่องมือและวัสดุที่ใช้ในการทดลอง	52
เครื่องเคลือบพิล์มน้ำระบบบรีเอคติฟ ดีซี สปีดเตอร์ริง	55
การสร้างสภาพสุญญาแก๊ส.....	56
การเตรียมวัสดุรองรับสำหรับการเคลือบพิล์มน้ำบางชอร์โโคเนียมออกไซด์	58
การเคลือบพิล์มน้ำบางชอร์โโคเนียมออกไซด์	59
การวิเคราะห์พิล์มน้ำบางชอร์โโคเนียมออกไซด์	61
แนวทางการทดลอง	66
1. การศึกษาผลของอัตราไอลแก๊สออกซิเจน	66
2. การศึกษาผลของระยะห่างระหว่างเปลาสารเคลือบกับวัสดุรองรับ	67
3. การศึกษาผลของความหนา	68
4. การศึกษาสมบัติทางแสงของพิล์มน้ำบางชอร์โโคเนียมออกไซด์	69
4 ผลการวิจัย.....	70
ผลของอัตราไอลแก๊สออกซิเจน	70
ผลของระยะห่างระหว่างเปลาสารเคลือบกับวัสดุรองรับ	75
ผลของความหนา	81
สมบัติทางแสงและแบบพลังงานพิล์มน้ำบางชอร์โโคเนียมออกไซด์	87
5 อภิปรายและสรุปผล	91
อภิปราย	91
สรุปผล.....	98

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
บรรณานุกรม.....	99
ภาคผนวก.....	104
ภาคผนวก ก การคำนวณหาค่าคงที่แลตทิซ (Lattice constants) และ ^๑ ขนาดผลึก (Crystallite size)	105
ภาคผนวก ข ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่	118
ประวัติย่อของผู้วิจัย.....	130

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2-1 พลังงานจีดเริ่มของเป้าสารเคลือบชนิดต่าง ๆ	13
2-2 ระบบผลึกของพิล์มนบางเชอร์โโคเนียมออกไซด์.....	42
2-3 ข้อมูลการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของผลึกเชอร์โโคเนียมออกไซด์เพสโนคลินิก	43
2-4 ข้อมูลการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของผลึกเชอร์โโคเนียมออกไซด์เพสเดตระโภนอล....	44
2-5 ข้อมูลการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของผลึกเชอร์โโคเนียมออกไซด์เพสคิวบิก	45
3-1 เงื่อนไขการเคลือบพิล์มนบางเชอร์โโคเนียมออกไซด์ ที่อัตราไหลดแก๊สออกซิเจนต่าง ๆ	67
3-2 เงื่อนไขการเคลือบพิล์มนบางเชอร์โโคเนียมออกไซด์ ที่ระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับต่าง ๆ	68
3-3 เงื่อนไขการเคลือบพิล์มนบางเชอร์โโคเนียมออกไซด์ที่เวลาเคลือบต่าง ๆ	69
4-1 ค่าคงที่แลตทิชของพิล์มนบางเชอร์โโคเนียมออกไซด์ ที่อัตราไหลดแก๊สออกซิเจนต่าง ๆ	72
4-2 ขนาดผลึกของพิล์มนบางเชอร์โโคเนียมออกไซด์ที่อัตราไหลดแก๊สออกซิเจนต่าง ๆ....	72
4-3 ความหนาและความหมายผิวของพิล์มนบางเชอร์โโคเนียมออกไซด์ ที่อัตราไหลดแก๊สออกซิเจนต่าง ๆ	74
4-4 ค่าคงที่แลตทิชของพิล์มนบางเชอร์โโคเนียมออกไซด์ ที่ระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับต่าง ๆ	77
4-5 ขนาดผลึกของพิล์มนบางเชอร์โโคเนียมออกไซด์ ที่ระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับต่าง ๆ	77
4-6 ความหนาและความหมายผิวของพิล์มนบางเชอร์โโคเนียมออกไซด์ ที่ระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับต่าง ๆ	80
4-7 ค่าคงที่แลตทิชของพิล์มนบางเชอร์โโคเนียมออกไซด์ที่เวลาเคลือบต่าง ๆ	83
4-8 ขนาดผลึกของพิล์มนบางเชอร์โโคเนียมออกไซด์ที่เวลาเคลือบต่าง ๆ	83
4-9 ความหนาและความหมายผิวของพิล์มนบางเชอร์โโคเนียมออกไซด์ ที่เวลาเคลือบต่าง ๆ	86
ก-1 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของผลึกเชอร์โโคเนียมออกไซด์	109

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
2-1 การก่อเกิดฟิล์มบาง	6
2-2 โครงสร้างของการเกิดฟิล์มในรูปแบบต่าง ๆ	8
2-3 อันตรกิริยาระหว่างไอออนกับพื้นผิวสัมผัสดู	10
2-4 ลักษณะของเครื่องเคลือบสุญญากาศด้วยวิธีสปัตเตอริ่ง	11
2-5 ยีลด์ของทองแดงที่ถูกชนด้วยไอออนจากแก๊สอาร์กอนที่พลังงานต่าง ๆ	13
2-6 การเปลี่ยนแปลงค่า yield ของเป้าทองแดง (Cu) , เงิน (Ag) และแทนทาลัม (Ta) เมื่อใช้ไอออนพลังงาน 45 keV จากธาตุที่มีเลขอะตอมค่าต่าง ๆ	15
2-7 การเปลี่ยนแปลงของยีลด์เมื่อใช้ไอออนของprototh พลังงาน 200 eV ชนเปานิเกล (Ni), โมลิบดินัม (Mo), ทังสเตน (W) และทองคำขาว (Pt) ที่มุนการตกกระแทบค่าต่าง ๆ (วัดเทียบกับแนวชนตั้งคากบนเป้า)	15
2-8 ความสัมพันธ์ของความหนาแน่นกระแสและแรงดันไฟฟ้าระหว่างข้ออิเล็กโทรด ของกระบวนการเกิด ดีซี โกลว์ดิสชาร์จ ในหลอดสุญญากาศบรรจุแก๊สนีโอน	17
2-9 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้าทางเดียวและผลคูณระหว่างความดัน (P) และระยะระหว่างอิเล็กโทรด (d)	18
2-10 โกลว์ดิสชาร์จของหลอดคันนีโอนยาว 50 cm ที่ความดัน 1.33 mbar	19
2-11 ระบบสปัตเตอริ่งแบบ ดีซี สปัตเตอริ่ง	21
2-12 ผลของความดันในระบบที่มีผลต่ออัตราเคลือบ ค่า yield และกระแสไฟฟ้าใน ระบบสปัตเตอริ่งของนิกเกลที่ใช้แรงดันไฟฟ้า 3,000 V ระหว่างข้ออิเล็กโทรด ที่วางห่างกัน 4.5 cm	22
2-13 การเคลื่อนที่ของอนุภาคอิเล็กตรอนในสนามแม่เหล็ก	23
2-14 การเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามต่าง ๆ โดยที่ a , b , c เป็นการเคลื่อนที่ของ อนุภาคประจุในสนามแม่เหล็กอย่างเดียวส่วน d และ e เป็นการเคลื่อนที่ของ อนุภาคประจุในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าร่วมกันในลักษณะต่าง ๆ	25
2-15 การจัดสนามแม่เหล็กและแนวการกัดกร่อนของเป้าสารเคลือบในระบบพลาเรร์ แมgnีตรอน สปัตเตอริ่ง	26
2-16 ลักษณะเส้นแรงแม่เหล็กของระบบอันบานานซ์ แมgnีตรอน สปัตเตอริ่ง	28
2-17 ลักษณะพลาสม่าของระบบสปัตเตอริ่ง	29

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
2-18 การเกิดปฏิกิริยารวมตัวกันเป็นสารประกอบระหว่างแก๊สไวน์ปฏิกิริยากับอะตอม เปื้าสารเคลือบในบริเวณต่าง ๆ	30
2-19 แบบจำลองการเรียงตัวของอะตอม	33
2-20 ความเข้มของพีคที่แสดงถึงระนาบผลึกของวัสดุในตำแหน่งที่มีการสะท้อนรังสี.....	35
2-21 องค์ประกอบหลักของเครื่องมือ Scanning Probe Microscope	36
2-22 ลักษณะของแรงกระทำระหว่างอะตอมที่เกิดขึ้นในระยะห่างระหว่างวัสดุต่าง ๆ	37
2-23 เครื่อง AFM แบบ Multimode	38
2-24 ลักษณะการสั่นของคานที่มีเย็บติด	39
2-25 เพสของเซอร์โโคเนียมออกไซด์	42
3-1 ครอบแนวความคิดของการวิจัย	51
3-2 เครื่องเคลือบสูญญากาศระบบ รีแอคติฟ ดีซี เม肯ีตرون สปีตเตอริง ที่ใช้ในงานวิจัย	53
3-3 เครื่อง X-Ray Diffractrometer	53
3-4 เครื่อง Atomic Force Microscope	54
3-5 เครื่อง Spectrophotometer	54
3-6 ไดอะแกรมของเครื่องเคลือบ	55
3-7 ไดอะแกรมระบบเครื่องสูบสูญญากาศ ของระบบเคลือบสปีตเตอริง	57
3-8 การถ่ายวัสดุคงรับ	58
3-9 การเคลือบฟิล์มบางเซอร์โโคเนียมออกไซด์	60
3-10 ตัวอย่างซอง (Envelope) ครอบสเปกตรัมการส่งผ่านแสงสำหรับใช้ใน การคำนวณหาดัชนีหักเห ตั้มประสิทธิ์การดับสูญ	64
3-11 ตัวอย่างเส้นตั้งฉากที่ความยาวคลื่นที่สนใจ	64
3-12 การวิเคราะห์ฟิล์มบางเซอร์โโคเนียมออกไซด์	65
4-1 รูปแบบการเลี้ยงบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางเซอร์โโคเนียมออกไซด์ ที่อัตราไฟลแก๊สออกซิเจนต่าง ๆ	71
4-2 ลักษณะพื้นผิวแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ของฟิล์มบางเซอร์โโคเนียมออกไซด์ ที่วิเคราะห์ด้วยเทคนิค AFM ที่อัตราไฟลแก๊สออกซิเจนต่าง ๆ	73

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
4-3 ความหนาและความหยาบผิวของพิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์ที่อัตราไอลเก็สออกซิเจนต่าง ๆ	74
4-4 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของพิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์ที่ระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับต่าง ๆ	76
4-5 ลักษณะพื้นผิวแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ของพิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์ที่วิเคราะห์ด้วยเทคนิค AFM ที่ระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับต่าง ๆ	78
4-6 ความหนาและความหยาบผิวของพิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์ที่ระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับต่าง ๆ	80
4-7 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของพิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์ที่เวลาเคลือบต่าง ๆ	82
4-8 ลักษณะพื้นผิวแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ของพิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์ที่วิเคราะห์ด้วยเทคนิค AFM ที่เวลาเคลือบต่าง ๆ	84
4-9 ความหนาและความหยาบผิวของพิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์ที่เวลาเคลือบต่าง ๆ	86
4-10 เปอร์เซ็นต์การส่งผ่านแสงของพิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์ที่เวลาเคลือบต่าง ๆ ..	88
4-11 ดัชนีหักเหของพิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์เคลือบที่เวลาเคลือบต่าง ๆ	88
4-12 สัมประสิทธิ์การดับสัญญาณพิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์ที่เวลาเคลือบต่าง ๆ ..	89
4-13 แทนพลังงานของพิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์ที่เวลาเคลือบต่าง ๆ	90
ก-1 แกนสมมุติและมุมขึ้นภายในรูปผลึก.....	106
ก-2 แบบจำลองการเรียงตัวของอะตอม.....	108
ก-3 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของพิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์	109
ก-4 Effect of crystallite size on diffraction curves (schematic)	116
ก-5 การหาความกว้างครึ่งหนึ่งของพีคที่มีค่าความเข้มสูงสุด	117